Microstructure and optical properties of Fe-doped ZnO thin films deposited by spray pyrolysis

Sharife Gholami, Abolghasem Avazpour*, Ali Modabberasl

Department of Physics, Faculty of Science, Yasouj University, Yasouj, Iran Received: 18.02.2021 Final revised: 09.05.2021 Accepted: 03.08.2021 Doi link: 10.22055/JRMBS.2021.17018

Abstract

In the present study, Fe-doped ZnO ($Zn_{1-x}Fe_xO$) thin films were deposited by simple chemical spray pyrolysis technique on glass substrates at substrate temperature of 300 °C. The effect of Fe-doping concentration on the structural, morphological and optical properties of deposited films was studied. The X-ray diffraction (XRD) analyses indicates that all the obtained samples have a hexagonal wurtzite crystal structure without any secondary phases. The atomic force microscopy (AFM) images show that the morphology features changes with the increase of Fe-doping concentration and a denser microstructure and smoother surface obtained. The Fourier transform infrared (FTIR) spectra shows the presence of the stretching vibration mode of ZnO, functional groups, chemical bonding and iron in the doped ZnO thin films. Optical studies indicate that the absorption edge of deposited film shifted towards higher-wavelength direction and their optical band-gaps are decreased with the increase of Fe-doping concentration.

Keywords: Spray pyrolysis, ZnO thin films, Fe-doped, Structure properties, Optical properties



مقاله يؤوهشى

) کامل

ویژگیهای میکروساختاری و اپتیکی لایههای نازک اکسید روی آلایش

یافته با آهن ساخته شده بهروش اسپری پایرولیزیز

شریفه غلامی، ابوالقاسم عوض پور*، علی مدبراصل گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

دريافت: 1399/11/30 ويرايش نهائي: 1400/02/19 پذيرش: 1400/05/12

Doi link: 10.22055/JRMBS.2021.17018

چکیدہ

در این پژوهش، لایههای نازک اکسید روی آلایش یافته با آهن (Zn_{1-x}Fe_xO) با روش ساده و شیمیایی اسپری پایرولیزیز روی زیرلایهٔ شیشه در دمای زیرلایه 2°300 ساخته شدند. تأثیر میزان آلایش آهن روی ویژگیهای ساختاری، ریختشناسی و اپتیکی لایههای نازک ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل پراش پرتو ایکس نشان داد که همهٔ نمونههای ساخته شده، ساختار بلوری ورتسایت هگزاگونال بدون هیچ گونه فاز ناخالصی دارند. تصاویر میکروسکوپی نیروی اتمی نشان داد که با افزایش میزان آلایش آهن، ویژگیهای سطحی تغییر میکنند و لایههای با سطح بههم پیوسته و و میکروساختاری چگال تر بهدست می آید. نتایج طیف سنج مادون قرمز، حضور مدهای ارتعاشی مربوط به ZnO گروههای عاملی، پیوندهای شیمیایی و حضور آهن در ساختار را نشان داد. مطالعات اپتیکی نشان داد که با افزایش غلظت آلایش آهن، لبهٔ جذب اپتیکی بهسمت طول موجهای بلندتر جابهجا

کلیدواژگان: اسپری پایرولیزیز، لایههای نازک ZnO، آلایش آهن، ویژگیهای ساختاری، ویژگیهای اپتیکی

مقدمه

در سالهای اخیر نیمرساناهای اکسید روی¹ (ZnO) با توجه به ویژگیهای فیزیکی عالی و پتانسیل کاربردی فراوان آنها در زمینههای مختلف، بسیار مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفتهاند. ZnO مادهای فراوان، غیرسمی و ارزان نسبت به سایر مواد است. این ماده، نیمرسانای نوع n با گاف انرژی پهن و مستقیم oda در انرژی پیوندی اکسایتون بالای 4006 در دمای اتاق می باشد [2-1]. این نیمرسانا ویژگیهای

جالبی همانند پیزوالکتریکی، پایداری شیمیایی، رسانندگی حرارتی بالا، شفافیت اپتیکی بالا در ناحیهٔ مرئی، زیستسازگاری و تحرکپذیری بالای الکترون را دارا میباشد. همچنین با توجه به کاربردهای وسیع آنها در حسگرهای گازی، صفحات نمایش ابزارهای اپتوالکتریک، الکترودهای رسانای شفاف در سلولهای خورشیدی، مواد پیزوالکتریک و طراحیهای اسپیترونیک بسیار مورد توجه هستند [5-1]. بهمنظور بهبود رفتار فیزیکی ZnO بهعنوان مادهای با پتانسیل

^{*} نويسندهٔ مسئول: avazpour@yu.ac.ir

کاربردی چندمنظوره برای کاربردهای فوق الذکر، آلایش این ماده می تواند یک رهیافت مؤثر باشد. آلایش با عناصر مختلف و مناسب می تواند منجر به تقویت و کنترل ویژگیهای ساختاری، الکتریکی و اپتیکی لایههای نازک ZnO شود. همچنین با آلایش، تعداد حاملهای بار و رسانندگی در این لایهها برای کاربردهایی همانند ابزارهای اپتوالکترونیک بهبود می یابند [6]. از این رو لایههای نازک ZnO آلاییده شده، با توجه به ویژگیهای عالی اپتیکی و الکتریکی آنها، می توانند کاندیدای مناسبی برای تولید لایههای اکسید رسانای شفاف¹ (TCO) در سلولهای خورشیدی باشند.

مطالعات مختلفي در خصوص تأثير آلايش عناصر مختلف بهويژه فلزات واسطه² همانند V [7]، Cr [8]، [12] Fe و [11] Cu ([10] Ni ([9] Co [12] و [12] روى لايه هاى نازک ZnO [21-7]، بهمنظور بهبود کیفیت بلوری و بهینه سازی یا اصلاح ویژگیهای این لایهها انجام شده است. با این حال، تعداد پژوهش های کمتری به ساخت و مطالعهٔ ویژگیهای لایههای نازک ZnO آلاییده شده با آهن و ساخته شده بهروش های متفاوت لایهنشانی صورت گرفته است. لایه های نازک ZnO آلایش یافته با Fe می تواند ماده ای مهم و مناسب برای کاربر دهای چندمنظوره باشد [12]. از این رو مطالعهٔ ویژگیهای ساختاري، ايتيكي و الكتريكي أن و همچنين ارتباط ميان این ویژگی ها حائز اهمیت است. برای ساخت لایههای نازک از جمله ZnO، از روش های فیزیکی و شیمیایی مختلفي همانند اسياترينگ مگنترون³ [14-13]، لايەنشانى لىزر پالسى⁴ [15]، اسپرى پايرولىزىز⁵ [16]، و

و لایهنشانی چرخشی⁶ [17]، سل-ژل⁷ [18و12] استفاده میشود. در میان این روشها، اسپری پایرولیزیز با توجه به مزیتهایی همچون سادگی، ارزان بودن و عدم نیاز به تجهیزات خلأ مورد توجه و استفاده بیشتری قرار گرفته است.

این پژوهش با هدف بررسی و مطالعهٔ ارتباط میان میکروساختار و ویژگیهای ریختشناسی و اپتیکی لایههای نازک ZnO آلایش یافته با آهن (Zn_{1-x}Fe_xO) انجام گرفت. بدین منظور، لایههای نازک Zn_{1-x}Fe_xO با روش اسپری پایرولیزیز روی زیرلایه شیشه در دمای زیرلایه 2°300 ساخته شدند و تأثیر میزان غلظت آلایش Fc روی ویژگیهای ساختاری، ریختشناسی و اپتیکی نمونههای ساخته شده با جزئیات مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

جزئيات تجربى

در این پژوهش لایههای نازک Zn_{1-x}Fe_xO بهازای مقادیر 1/0 و 0,008، 0,006، 2,009، 9 x بهروش اسپری پایرولیزیز بر روی زیرلایههای شیشه ساخته شدند. تمیزکاری و شستشوی زیرلایهها بهترتیب با استون، اتانول و آب یونزدایی شده انجام شد. برای تهیهٔ پیش ماده مورد نظر از مواد اولیه استات روی دو آبه با فرمول شیمیایی 2H₂O(CH₃COO)2.2H₂O کلرید آهن شش آبه با فرمول شیمیایی کلرید آهن شش آبه با فرمول شیمیایی شده استفاده شد. ابتدا محلول استات روی با غلظت مولی 0/10 مولار در آب یون زدایی شده و 2-پروپانول با نسبت 1 به 4 آب و الکل تهیه و همچنین به منظور

⁵ Spray pyrolysis

⁶ Spin coating

⁷ Sol-gel

¹ Transparent conductive oxide

² Transition metals

³ Magnetron sputtering

⁴ Pulsed laser deposition (PLD)

ساخته شده با درصدهای مختلف آلایش را نشان مىدهد. همانگونه كه از شكل1 پيداست، تمامى لایههای ساخته شده ساختار بسبلوری دارند و طيف های XRD نمونه ها شامل چندين قله مربوط به ساختار بلوری ورتسایت هگزاگونال ZnO مطابق با شماره كارت استاندارد 1533-075-01 مى باشند. نتايج XRD نشان میدهد تمامی لایههای نازک ZnO آلایش یافته با آهن، الگوی پراش و قلههایی همانند لایه نازک ZnO خالص دارند و با افزایش مقدار x هیچ گونه فاز ناخالصی و یا قلهٔ جدیدی همانند فازهای FeO، Fe₃O₄ ،Fe₂O₃ در طيفها ظاهر نمى شود. بنابراين مشاهده می شود آلایش آهن ساختار بلوری ZnO را در نمونههای تهیه شده دستخوش تغییر نکرده است. بهعبارت دیگر، همهٔ لایههای نازک آلایش یافته ساختار بلورى ورتسايت هگزاگونال دارند. اين موضوع نشان میدهد که یونهای آهن بهطور کامل و مناسب در ساختار ZnO وارد شده و جایگزینی موفقیتآمیز یونهای Fe به جای یونهای Zn در شبکهٔ En صورت گرفته است. نتایج XRD نشان میدهد که شدت، موقعیت زاویهای (θ) و اندازهٔ پهنا در نصف ماکزیمم (FWHM) قلهٔ(101) با افزایش مقدار x تغییر محسوسی نمیکنند. نتایج بهدست آمده از برخی پژوهش های قبلی [17و16] نیز نشان میدهد که آلایش آهن تا مقدار ده درصد (x =0/1) ساختار بلوری ورتسایت هگزاگونال ZnO را در نمونههای . Fe_xO دستخوش هیچ گونه تغییری نمی کند. اما افزایش مقدار آلایش آهن بالاتر از ده درصد منجر به ایجاد فاز

افزایش احیای شیمیایی و جهت افزایش حلالیت استات روی، از چند قطره اسید استیک استفاده شد. برای تهیهٔ نمونههای جانشانی شده، محلولهای پیشمادهها با افزودن کلرید آهن با غلظت مولی در گسترهٔ 0/0≤x≤0/1 تهیه شدند. عملیات اسپری و لایهنشانی همهٔ نمونهها، از طریق نازل اسپری با ارتفاع 35cm و قطر حدود 0/8mm، در دمای زیرلایه C°300، با آهنگ اسپری 15cc/min بەمدت زمان 25دقیقه و بدون هیچ وقفهای انجام شد. در حین لایهنشانی، صفحهٔ داغ دستگاه (زیرلایهٔ نگهدار) بهصورت چرخشی حرکت میکرد. برای بررسی ویژگیهای ساختاری نمونهها از الگوی پراش پرتو ایکس¹ (تابش CuKα₁ از دستگاه ultra IV, Japan) استفاده شد. ریختشناسی سطح لايه ها با ميكروسكوب نيروى اتمى²(AFM) مدل WITec-Alpha300A,Germany مطالعه شد. بهمنظور مطالعهٔ ویژگیهای ایتیکی لایهها از دستگاه طيف سنج مادون قرمزPerkinelmer-÷-FTIR³ spectrum two, USA و دستگاه طيف سنج مدل UV-Vis در محدودة PerkinElmer lambda 25 استفاده شد.

نتايج و بحث

ویژگیهای ساختاری

لایههای نازک Zn_{1-x}Fe_xO با روش اسپری پایرولیزیز روی زیرلایه شیشه در دمای زیرلایه 2°300 ساخته شدند. لایههای ساخته شده دارای سطحی پیوسته، یکنواخت و بدون خلل و فرج بودند. شکل 1 الگوی پراش پرتو ایکس(XRD) مربوط به نمونههای

³ Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)

¹ X-ray diffraction (XRD)

² Atomic force microscopy (AFM)

ناخالصی همانند Fe₃O4 و یا تضعیف کیفیت بلوری نمونههای ساخته شده در این پژوهش ها شده است. پارامترهای شبکه a d (a=b)، c و نسبت $\frac{c}{a}$ برای لایههای نازک تهیه شده محاسبه شدند. این مقادیر برای (0/323nm بازک تهیه شده محاسبه شدند. این مقادیر برای پارامترهای a، c و نسبت $\frac{c}{a}$ بهترتیب 20/323nm پارامترهای a، c و نسبت أمدند. مشاهده شد که این پارامترها برای تمامی نمونهها، مقادیر تقریباً یکسانی دارند. این رفتار در توافق با مشاهدات گزارش شده توسط سایرین است [16]. علت عدم تغییر محسوس در پارامترهای شبکه را میتوان به ختلاف ناچیز و اندک شعاعهای یونی مربوط به یونهای جانشانی شدهٔ Fe شعاعهای یونی مربوط به یونهای جانشانی شدهٔ IC نسبت داد. شعاع یونی Fe^{+2} و Fe^{+3} بهترتیب mm نسبت داد. شعاع یونی Fe^{+3} و Fe^{+3} بهترتیب mm نسبت داد. شعاع یونی 9/068 میام مدار m



شکل1. الگوی پراش پرتو ایکس لایههای نازک Zn_{1-x}Fe_xO بهازای مقادیر مختلف x.

مطالعة ريختشناسي

شکل2 تصاویر میکروسکوپی AFM مربوط به لایههای نازک Zn_{1-x}Fe_xO بهازای درصدهای مختلف آلایش را نشان میدهد. این تصاویر بهخوبی تغییرات

در ریختشناسی و توپو گرافی سطح لایهها را با افزایش غلظت آلایش نشان می دهند. مشاهده می شود که سطح نمونههای آلایش یافته، حاوی تعداد زیادی جزیره با اندازههای مختلف، شکلهای نامنظم و به صورت جداگانه و به هم پیوسته می باشد. با افزایش میزان درصد آلایش ویژگی های سطحی تغییر می کنند. بدین صورت که تعداد دانه ها کاهش می یابند و لایه های با سطح به هم پیوسته تر و میکروساختاری چگال تر به دست می آید. چنین رفتار ریخت شناسی مشابهی برای لایه های نازک مات ZnO:Mn گزارش شده است [19].



شکل2. تصاویر دو و سه بعدی AFM مربوط به نمونههای الف: x =0 ب: cx =0/10 و ج: x =0/10.

ویژگیهای اپتیکی

برای شناسایی پیوندهای موجود در بین مولکولها و بررسی تغییرات ساختاری، از نمونهها طیف FTIR گرفته شد. شکل3 طیف حاصل از این تحلیل برای نمونههای ساخته شده را در بازهٔ عدد موجی ¹⁻⁴⁰⁰cm

تا ¹-4000cm نشان می دهد. پیک پهن جذبی واقع در محدودهٔ عدد موجی ¹-3200 cm موجود در ترکیب ارتعاشهای کششی گروه O-H موجود در ترکیب نمونههای تهیه شده است [20]. مدهایی که در موقعیتهای ¹-2754 cm 2960 مشاهده میشوند، مربوط بهارتعاشات خمشی گروه C-H هستند. همچنین پیک جذبی مشاهده شده در محدودهٔ



شکل3. طیف FTIR لایههای نازک Zn_{1-x}Fe_xO بهازای مقادیر مختلف x.



شکل4. طیف جذب لایه های نازک Zni-Fe_sO به ازای مقادیر مختلف x شکل5 تغییرات تقریبی لبهٔ جذب لایه های ساخته شده را بر حسب درصد آلایش آهن نشان می دهد.



¹ می اشد و به دلیل حضور مولکول CO₂ در محیط می اشد که در طیف ها خود را نشان داده است [21]. مد ارتعاشی موجود در موقعیت حدودی ¹-1550cm مربوط به ارتعاشات کششی گروه C=O در ترکیب می اشد [20]. مد قوی ارتعاشی ظاهر شده در موقعیت می اشد [20]. مد قوی ارتعاشی ظاهر شده در موقعیت حدودی ¹-250cm را می توان به مدهای O ح و می اشد (20]. مد قوی ارتعاشی طاهر شده در موقعیت حدودی ¹-250cm را می توان به مدهای O ح و در مکانهای بین شبکه O در ساختار دارتعاشی و کششی مربوط به شبکه O ارتعاشی ارتعاشی و کششی مربوط به شبکه O ح در کیری مناسب یونهای آهن در ساختار O در مکانهای بین نشینی ZnO آهن در ساختار O در مکانهای بین نشینی ZnO

شکل 4 طیفهای جذب لایههای ناز ک Zn₁-xFe_xO بر بر حسب x در محدوهٔ طول موج 3000-000 نشان می دهد. از این شکل پیداست که تمامی لایههای ساخته شده دارای جذب قوی در محدودهٔ طول موجهای بالاتر از 350-400 و جذب تقریباً صفر در طول موجهای بالاتر از 400nm می باشند. همچنین در گسترهٔ طول موجهای 400nm-350، افزایش میزان جذب با کاهش طول موج برای همهٔ نمونههای ساخته شده نیز مشاهده می شود. این امر نشان دهندهٔ جذب ذاتی نمونهها به دلیل انتقال مستقیم الکترونها و نشاندهندهٔ نیم رسانا بودن نمونههای ساخته شده با انرژی گاف مستقیم می باشد [22و 22].

مشاهده می شود که با افزایش X، لبهٔ جذب به سمت طول موجهای بلندتر جابه جا می شود. این رفتار در توافق با گزارشات دیگران برای لایه های نازک Rn_{1-x}Fe_xO ساخته شده به روش های مختلف لایه نشانی همانند سل-ژل، اسپاترینگ مگنترون و لایه نشانی چرخشی می باشد [12،13،2٤،۲٥]. جابه جایی مشاهده شده در لبهٔ جذب به سمت طول موجهای بلندتر را می توان به ایجاد نقص ها و افزایش آنها در ساختار در اثر آلایش آهن نسبت داد [25و13]. برای بررسی دقیق تر ویژگی های اپتیکی به ویژه تغییرات انرژی گاف اپتیکی از رابطهٔ تایوک (مطابق فرمول زیر) استفاده شد [26].

$$\alpha h v = A \left(h v - E_s \right)^{1/2}$$
 1

در این رابطه A ضریب ثابت، α ضریب جذب اپتیکی، hv انرژی فوتون و E_s انرژی گاف اپتیکی می باشد. hv با برازش خط منحنی $(\alpha hv)^2$ برحسب hv و از روی طول از مبدأ آن می توان مقدارگاف اپتیکی را تخمین زد (شکل 6).



شکل6. تغییرات ²(αhv) برحسب hvمربوط به لایههای نازک (αhv znu) در منتلف x.

برای وضوح بهتر، تغییرات انرژی گاف اپتیکی لایههای نازک ساخته شده برحسب غلظت آلایش آهن در شکل7 نشان داده شده است.



شکل7. تغییرات انرژی گاف اپتیکی نمونهها برحسب مقدار x.

از این شکل پیداست که انرژی گاف با افزایش X بهطور تدریجی کاهش مییابد. این رفتار با مطالعات دیگران برای لایههای نازک Zn_{1-x}Fe_xO ساخته شده با دیگر روش های لایهنشانی همخوانی دارد [24و12]. چنانچه در مرجع [17] اشاره شده است علت کاهش انرژی گاف این لایههای نازک، میتواند به برهم کنش تبادلی ماف این لایههای نازک، میتواند به برهم کنش تبادلی ماو s-p بین الکترونهای نواری و الکترونهای جایگزیده اوربیتال d مربوط به یونهای FF جایگزین شده در موقعیت یونهای Zn در شبکه و ساختار ZnO نسبت داده شود. کاهش انرژی گاف اپتیکی با افزایش نسبت داده شود. کاهش انرژی گاف اپتیکی با افزایش

نتيجه گيري

در این پژوهش تأثیر درصدهای مختلف غلظت آلایش آهن روی ویژگیهای ساختاری، ریختشناسی و اپتیکی لایههای نازک Zn_{1-x}Fe_xO ساخته شده cost-efficient LED technology, *Proceedings* of the IEEE **98** (2010) 1281-1287. https://ieeexplore.ieee.org/document/54308 <u>82</u>

[4] B.-Y. Oh, M.-C. Jeong, T.-H. Moon, W. Lee, J.-M. Myoung, J.-Y. Hwang, D.-S. Seo, Transparent conductive Al-doped ZnO films for liquid crystal displays, *Journal of Applied Physics* **99** (2006) 124505. https://doi.org/10.1063/1.2206417

[5] A. Kumar, S.K. Saini, G. Sharma, A.K. Johar, Development and characterization of ZnO thin film for piezoelectric applications, Materials Today: Proceedings, *32* (2020) 261-263.

https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.01.351

[6] T. Srinivasulu, K. Saritha, K.R. Reddy, Synthesis and characterization of Fe-doped ZnO thin films deposited by chemical spray pyrolysis, *Modern Electronic Materials* 3 (2017) 76-85. <u>https://doi.org/10.1016/j.moem.2017.07.00</u> <u>1</u>

[7] M. Koleva, P. Atanasov, N. Nedialkov,
H. Fukuoka, M. Obara, Role of vanadium content in ZnO thin films grown by pulsed laser deposition, *Applied Surface Science* 254 (2007) 1228-1231.
<u>https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2007.07.18</u>
<u>0</u>

[8] S. Yılmaz, M. Parlak, Ş. Özcan, M. Altunbaş, E. McGlynn, E. Bacaksız, Structural, optical and magnetic properties of Cr doped ZnO microrods prepared by spray pyrolysis method, *Applied Surface Science* **257** (2011) 9293-9298. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2011.05.01 <u>7</u>

[9] P. Shishodia, Effect of cobalt doping on ZnO thin films deposited by sol-gel method,

بهروش اسپری پایرولیزیز بر روی زیر لایهٔ شیشه، مورد بررسی و بحث قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد که همهٔ لایههای خالص و آلاییده شده ساختار بلوری ورتسایت هگزاگونال دارند و هیچگونه فاز ناخالصی یا اضافهای در طیفهای XRD مشاهده نشد. از تصاویر ویژگیهای در طیفهای XRD مشاهده نشد. از تصاویر ویژگیهای سطحی تغییر میکنند و لایههای با سطح بههم پیوستهتر و میکروساختاری چگالتر بهدست میآیند. تحلیل FTIR، مدهای ارتعاشی مربوط به میآیند. تحلیل FTIR، مدهای ارتعاشی مربوط به گروههای عاملی بدون هیچگونه مد اضافهٔ مربوط به که با افزایش میزان آلایش، لبهٔ جذب اپتیکی نشان داد که با افزایش میزان آلایش، لبهٔ جذب اپتیکی نشان داد که با افزایش میزان آلایش، لبهٔ جذب اپتیکی نشان داد گاف اپتیکی با افزایش میزان آلایش Fe کاهش می یابد.

مرجعها

[1] A. Facchetti, T. Marks, *Transparent electronics: from synthesis to applications*, Joun Wiley, New Yourk, (2010). <u>https://www.wiley.com/en-</u> us/exportProduct/pdf/9780470710593

[2] C.S. Prajapati, Ajay Kushwaha, P.P. Sahay₂ Experimental Investigation of Spray-Deposited Fe-Doped ZnO Nanoparticle Thin Films: Structural, Microstructural, and Optical Properties, Journal of Thermal Spray Technology 22 (2013)1230-1241. https://link.springer.com/article/10.1007/s1 1666-013-9973-0

[3] A. Bakin, A. Behrends, A. Waag, H.-J. Lugauer, A. Laubsch, K. Streubel, ZnO-GaN hybrid heterostructures as potential [15] D. Chakraborti, J. Narayan, J. Prater, Room temperature ferromagnetism in Zn 1– x Cu x O thin films, *Applied Physics Letters* 90 (2007) 062504. https://doi.org/10.1063/1.2450652

[16] I. Soumahoro, R. Moubah, G. Schmerber, S. Colis, M.A. Aouaj, M. Abd-Lefdil, N. Hassanain, A. Berrada, A. Dinia, Structural, optical, and magnetic properties of Fe-doped ZnO films prepared by spray pyrolysis method, *Thin Solid Films* **518** (2010) 4593-4596. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2009.12.039

[17] U. Alver, T. Kılınc, E. Bacaksız, S. Nezir, Structure and optical properties of $Zn_{1-x}Fe_xO$ thin films prepared by ultrasonic spray pyrolysis, *Materials Science and Engineering B* 138 (2007) 74-77. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2007.01.026

[18] S.E. Mousavi Ghahfarokhi, M. Rahimi Larki, I. Kazeminezhad, Effect of annealing temperature on the structural and optical properties bismuth ferrite (BiFeO3) nanoparticle, *Journal of Research on Many Body Systems* **9** (2019) 179-191. https://dx.doi.org/10.22055/jrmbs.2019.146 00

[19] V. Shinde, T. Gujar, C. Lokhande, R. Mane, S.-H. Han, Mn doped and undoped ZnO films: A comparative structural, optical and electrical properties study, *Materials Chemistry and Physics* **96** (2006) 326-330. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.200 5.07.045

[20] M.M. Ba-Abbad, A.A.H. Kadhum, A.B. Mohamad, M.S. Takriff, K. Sopian, The effect of process parameters on the size of ZnO nanoparticles synthesized via the sol–gel technique, *Journal of Alloys and Compounds* 550 (2013) 63-70.

Thin Solid Films **612** (2016) 55-60. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2016.05.028

[10] X. Zhao, E. Liu, R. Ramanujan, J. Chen, Effects of rapid thermal annealing on structural, magnetic and optical properties of Ni-doped ZnO thin films, *Current Applied Physics* **12** (2012) 834-840. http://dx.doi.org/10.1016/j.cap.2011.11.016

[11] D.-L. Hou, X.-J. Ye, H.-J. Meng, H.-J. Zhou, X.-L. Li, C.-M. Zhen, G.-D. Tang, Magnetic properties of n-type Cu-doped ZnO thin films, *Applied Physics Letters* **90** (2007) 14250. <u>https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.2</u> <u>719034</u>

[12] L. Xu, X. Li, Influence of Fe-doping on the structural and optical properties of ZnO thin films prepared by sol-gel method, *Journal of Crystal Growth* **312** (2010) 851-855.

https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2009.12.0 62

[13] C. Wang, Z. Chen, Y. He, L. Li, D. Zhang, Structure, morphology and properties of Fe-doped ZnO films prepared by facing-target magnetron sputtering system, *Applied Surface Science* **255** (2009) 6881-6887.

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2009.03.00 8

[14] W. Yanga, J. Liua, Z. Guana, Z. Liua,
B.Chena, L. Zhao, Y. Lia, X. Caoa, Xin He,
Chi. Zhang., Q. Zenga, Yuechun Fu,
Morphology, electrical and optical
properties of magnetron sputtered porous
ZnO thin films on Si(100) and Si(111)
substrates, *Ceramics International* 46
(2020) 6606-6611.
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.11.
147

127

شریفه غلامی و همکاران

[24] A. Goktas, I. Mutlu, Y. Yamada, Influence of Fe-doping on the structural, optical, and magnetic properties of ZnO thin films prepared by sol–gel method, *Superlattices and Microstructures* **57** (2013) 139-149.

https://doi.org/10.1016/j.spmi.2013.02.010

[25] A. Rambu, V. Nica, M. Dobromir, Influence of Fe-doping on the optical and electrical properties of ZnO films, *Superlattices and Microstructures* **59** (2013) 87-96.

https://doi.org/10.1016/j.spmi.2013.03.023

[26] M. Kaid, A. Ashour, Preparation of ZnO-doped Al films by spray pyrolysis technique, *Applied surface science* **253** (2007) 3029-3033. <u>https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2006.06.04</u> <u>5</u> https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2012.09.0 76

[21] K. Raja, P. Ramesh, D. Geetha, Structural, FTIR and photoluminescence studies of Fe doped ZnO nanopowder by coprecipitation method, Spectrochimica, *acta part A: molecular and biomolecular spectroscopy* **131** (2014) 183-188. https://doi.org/10.1016/j.saa.2014.03.047

[22] X. Wang, C. Song, D. Li, K. Geng, F. Zeng, F. Pan, The influence of different doping elements on microstructure, piezoelectric coefficient and resistivity of sputtered ZnO film, *Applied Surface Science* 253 (2006) 1639-1643. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2006.02.05

[23] K. Vanheusden, C. Seager, W.t. Warren, D. Tallant, J. Voigt, Correlation between photoluminescence and oxygen vacancies in ZnO phosphors, *Applied physics letters* **68** (1996) 403-405. https://doi.org/10.1063/1.116699